

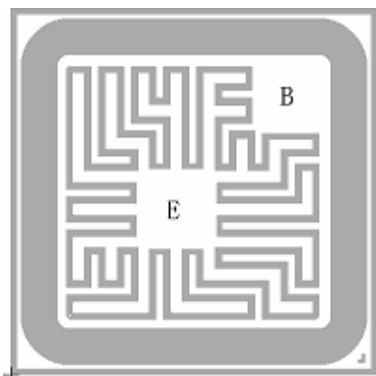
GS1450

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

■用 途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器、充电器及其它开关、振荡电路。

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1450 μ m× 1450 μ m
压焊点尺寸	基 区 310 μ m× 310 μ m 发射区 315 μ m× 315 μ m
芯片厚度	240± 10 μ m
锯片槽宽度	60 μ m
金属层:	正面: Al 4.0± 0.4 μ m 背面: Ag 1.4± 0.2 μ m

■电特性(T_a=25℃)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	单 位
集电极-基极反向电流	I _{CB0}	V _{CB} =570V		1	μA
发射极-基极反向电流	I _{EBO}	V _{EB} =9V		1	μA
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _C =0.1mA	600		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1mA	400		V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =0.1mA	9		V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =200mA	15	40	
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =200mA, I _B =50mA	1.5	3.0	V